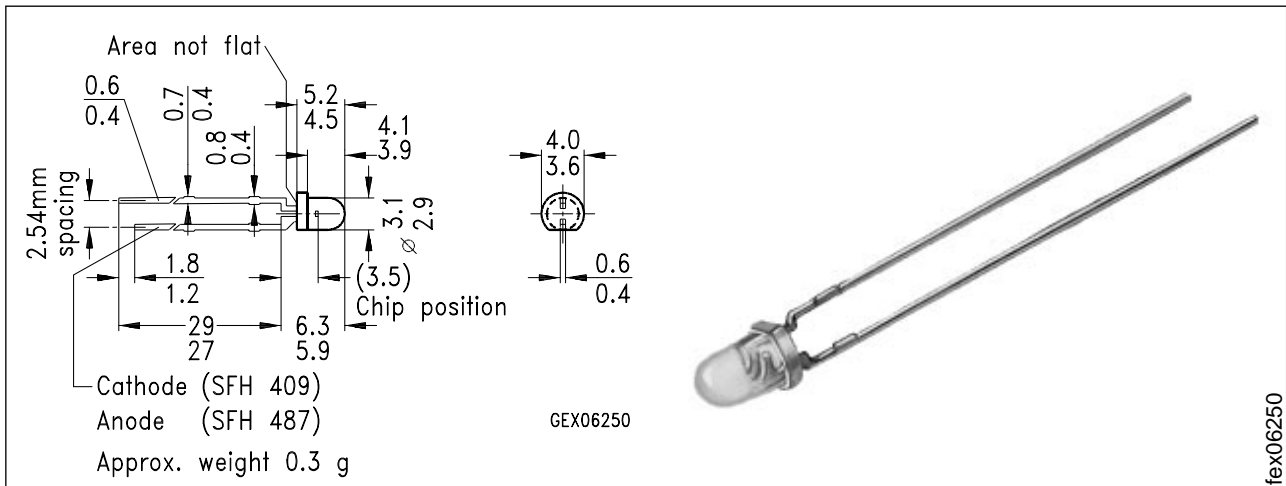


## GaAs-IR-Lumineszenzdiode GaAs Infrared Emitter

SFH 409



Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

### Wesentliche Merkmale

- GaAs-IR-Lumineszenzdiode, hergestellt im Schmelzepitaxieverfahren
- Hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Impulsbelastbarkeit
- Gruppiert lieferbar
- Gehäusegleich mit SFH 309, SFH 487

### Anwendungen

- Lichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb
- IR Fernsteuerungen

### Features

- GaAs infrared emitting diode, fabricated in a liquid phase epitaxy process
- High reliability
- High pulse handling capability
- Available in groups
- Same package as SFH 309, SFH 487

### Applications

- Photointerrupters
- IR remote control of various equipment

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code	Gehäuse Package
SFH 409	Q62702-P860	3-mm-LED-Gehäuse (T 1), grau eingefärbt, Anschlüsse im 2.54-mm-Raster ( $1/10''$ ), Kathodenkennzeichnung: kürzerer Anschluß
SFH 409-1 <sup>1)</sup>	Q62702-P1001	
SFH 409-2	Q62702-P1002	
		3 mm LED package (T 1), grey-colored epoxy resin, solder tabs lead spacing 2.54 mm ( $1/10''$ ), cathode marking: short lead

1) Nur auf Anfrage lieferbar.  
1) Available only on request.

**Grenzwerte ( $T_A = 25\text{ °C}$ )**  
**Maximum Ratings**

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{op}; T_{stg}$	- 55 ... + 100	°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	$T_j$	100	°C
Sperrspannung Reverse voltage	$V_R$	5	V
Durchlaßstrom Forward current	$I_F$	100	mA
Stoßstrom, $\tau \leq 10\ \mu\text{s}$ , $D = 0$ Surge current	$I_{FSM}$	3	A
Verlustleistung Power dissipation	$P_{tot}$	165	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance	$R_{thJA}$	450	K/W

**Kennwerte ( $T_A = 25\text{ °C}$ )**  
**Characteristics**

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Wellenlänge der Strahlung Wavelength at peak emission $I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$	$\lambda_{peak}$	950	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % von $I_{max}$ Spectral bandwidth at 50 % of $I_{max}$ $I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$	$\Delta\lambda$	55	nm
Abstrahlwinkel Half angle	$\varphi$	$\pm 20$	Grad deg.
Aktive Chipfläche Active chip area	$A$	0.09	mm <sup>2</sup>
Abmessungen der aktive Chipfläche Dimension of the active chip area	$L \times B$ $L \times W$	$0.3 \times 0.3$	mm
Abstand Chipoberfläche bis Linsenscheitel Distance chip surface to lens top	$H$	2.6	mm
Kapazität, $V_R = 0\text{ V}$ Capacitance	$C_o$	25	pF

### Kennwerte ( $T_A = 25\text{ °C}$ )

### Characteristics

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Schaltzeiten, $I_e$ von 10 % auf 90 % und von 90 % auf 10 %, bei $I_F = 100\text{ mA}$ , $R_L = 50\ \Omega$ Switching times, $I_e$ from 10 % to 90 % and from 90 % to 10 %, $I_F = 100\text{ mA}$ , $R_L = 50\ \Omega$	$t_r, t_f$	1	$\mu\text{s}$
Durchlaßspannung Forward voltage $I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$ $I_F = 1\text{ A}$ , $t_p = 100\ \mu\text{s}$	$V_F$ $V_F$	1.30 ( $\leq 1.5$ ) 1.9 ( $\leq 2.5$ )	V V
Sperrstrom Reverse current $V_R = 5\text{ V}$	$I_R$	0.01 ( $\leq 1$ )	$\mu\text{A}$
Gesamtstrahlungsfluß Total radiant flux $I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$	$\Phi_e$	15	mW
Temperaturkoeffizient von $I_e$ bzw. $\Phi_e$ , $I_F = 100\text{ mA}$ Temperature coefficient of $I_e$ or $\Phi_e$ , $I_F = 100\text{ mA}$	$TC_I$	- 0.55	%/K
Temperaturkoeffizient von $V_F$ , $I_F = 100\text{ mA}$ Temperature coefficient of $V_F$ , $I_F = 100\text{ mA}$	$TC_V$	- 1.5	mV/K
Temperaturkoeffizient von $\lambda_{\text{peak}}$ , $I_F = 100\text{ mA}$ Temperature coefficient of $\lambda_{\text{peak}}$ , $I_F = 100\text{ mA}$	$TC_\lambda$	+ 0.3	nm/K

### Gruppierung der Strahlstärke $I_e$ in Achsrichtung

gemessen bei einem Raumwinkel  $\Omega = 0.01\text{ sr}$

### Grouping of radiant intensity $I_e$ in axial direction

at a steradian of  $\Omega = 0.01\text{ sr}$

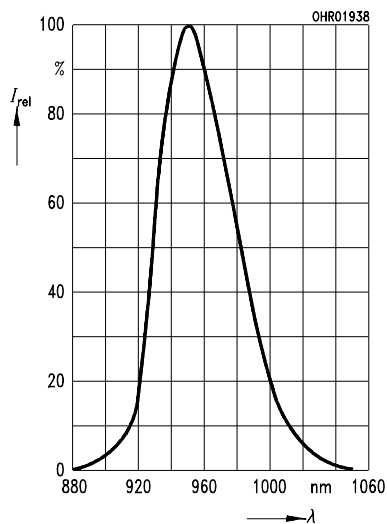
Bezeichnung Description	Symbol	Werte Values			Einheit Unit
		SFH 409	SFH 409-1 <sup>1)</sup>	SFH 409-2	
Strahlstärke Radiant intensity $I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$ $I_F = 1\text{ A}$ , $t_p = 100\ \mu\text{s}$	$I_e$ $I_{e\text{ typ.}}$	$\geq 6.3$	6.3 ... 12.5 75	$\geq 10$ 120	mW/sr mW/sr

1) Nur auf Anfrage lieferbar.

1) Available only on request.

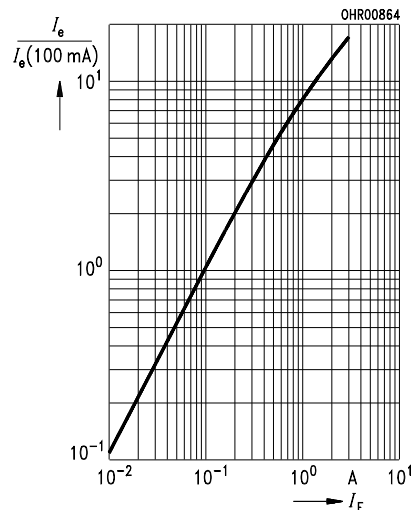
### Relative spectral emission

$$I_{rel} = f(\lambda)$$



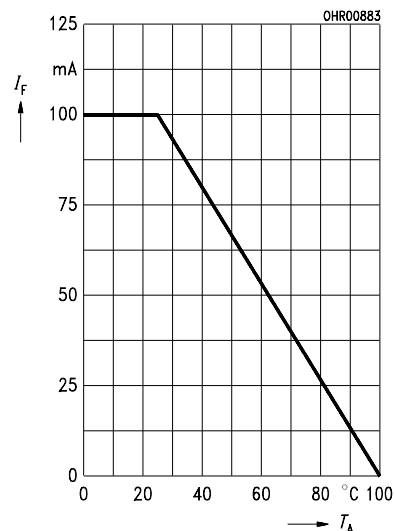
### Radiant intensity $\frac{I_e}{I_e 100 \text{ mA}} = f(I_F)$

Single pulse,  $t_p = 20 \mu\text{s}$



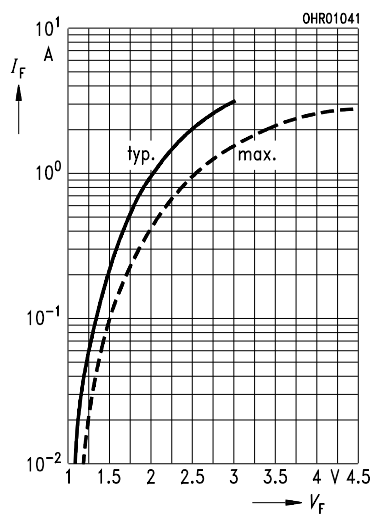
### Max. permissible forward current

$$I_F = f(T_A)$$



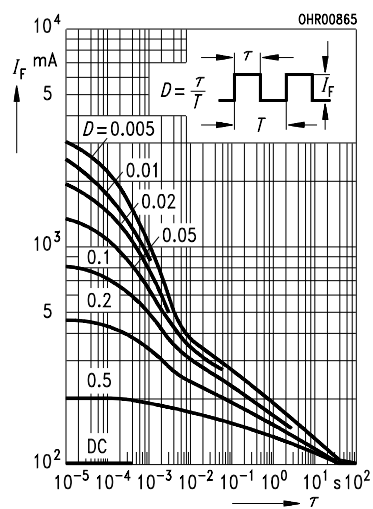
### Forward current

$$I_F = f(V_F), \text{ single pulse, } t_p = 20 \mu\text{s}$$



### Permissible pulse handling capability

$$I_F = f(\tau), T_A = 25^\circ\text{C}, \text{ duty cycle } D = \text{parameter}$$



### Radiation characteristics $I_{rel} = f(\varphi)$

